


	<h2 style="color: red;">FQD2N80TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N80TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD2N80TM.pdf  2.FQD2N80TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10813 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N80TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10813 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.8A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 900mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD2N80TMCT

















































FQD2N80TM ist neu im Original, Suche FQD2N80TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N80TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N80TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80 Fairchi FQD2N80 Fairchi</p>	 <p>FQD2N65C VB FQD2N65C VB</p>	 <p>FQD2N80TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>
 <p>FQD2N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM-NL FAIRCHILD FQD2N80TM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2N90 Fairchi FQD2N90 Fairchi</p>	 <p>FQD2N80TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD24N08TM	 FQD2N100	 FQD2N100TM	 D FQD2N100TM	 FQD2N30TF
 FQD2N40TM	 FQD2N40TM	 D FQD2N50B	 FQD2N50C	 FQD2N50TF
 FQD2N50TF	 FQD2N50TM	 FQD2N50TM	 FQD2N60A	 FQD2N60C
 D FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF-NL	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080
 FQD2N60CTM	 FQD2N60CTM	 FQD2N60TM	 FQD2N60TM	 FQD2N65C
 FQD2N80TM	 FQD2N80TM-NL	 D FQD2N90TF	 FQD2N90TF	 FQD2P25TF
 FQD2P25TM	 D FQD30N06	 FQD30N06L	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTF
 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080
 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TM	 FQD30N06TM	 D FQD30P06	 FQD3N25T
 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM	 FQD3N30TM	 FQD3N40TM

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

